



# TBA 810 S · TBA 810 AS

## Monolithisch Integrierte Schaltung Monolithic Integrated Circuit

**Anwendung:** NF-Leistungsverstärker

**Application:** Audio power amplifier

### Besondere Merkmale:

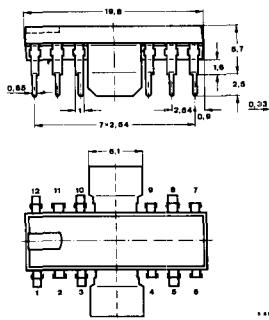
- Thermische Abschaltung
- Hoher Ausgangsstrom bis 2,5 A
- Großer Versorgungsspannungsbereich, 4 bis 20 V
- Hohe Ausgangsleistung, 7 W
- Kleine Übernahmeverzerrungen
- Kleiner Klirrfaktor
- Sehr guter Wirkungsgrad, 70%

### Features:

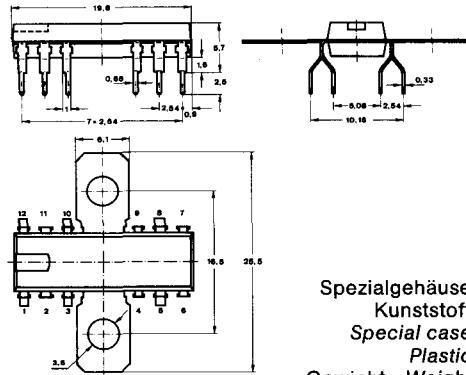
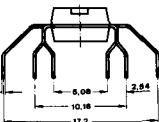
- Thermal shut-down
- High output current, up to 2.5 A
- Wide range of supply voltage, 4 to 20 V
- High output power 7 W
- Low cross-over distortion
- Low harmonic distortion
- Very high efficiency 70%

### Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

**Abmessungen in mm**  
**Dimensions in mm**



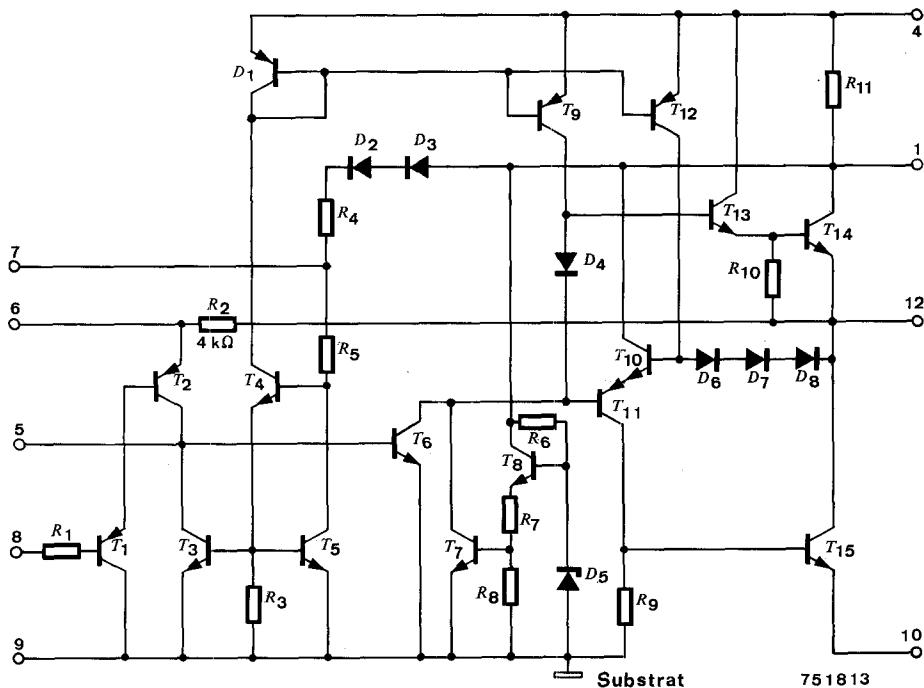
TBA 810 S



TBA 810 AS

Spezialgehäuse  
Kunststoff  
Special case  
Plastic  
Gewicht · Weight  
max. 1,5 g

# TBA 810 S · TBA 810 AS



**Fig. 1 Schaltung und Anschlußbelegung**  
*Diagram and pin connections*

**Absolute Grenzdaten**  
**Absolute maximum ratings**

Bezugspunkt      Pin 9, Pin 10  
Reference point

Versorgungsspannung <i>Supply voltage</i>	Pin 1	$U_S$	20	V
Ausgangsstoßstrom <i>Surge output current</i>	Pin 12	$I_{QS}$	3,5	A
Ausgangsspitzenstrom <i>Peak output current</i> (repetitive)	Pin 12	$I_{QM}$	2,5	A

Verlustleistung  
*Power dissipation*

$$t_{\text{amb}} = 80^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{case}} = 100^\circ\text{C}$$

Sperrsichttemperatur  
*Junction temperature*

Lagerungstemperaturbereich  
*Storage temperature range*

	TBA 810 S	$P_{\text{tot}}$	1	W
	TBA 810 AS	$P_{\text{tot}}$	5	W

$t_j$                   +150                  °C

$t_{\text{stg}}$                   -40 ... +150                  °C

# TBA 810 S · TBA 810 AS

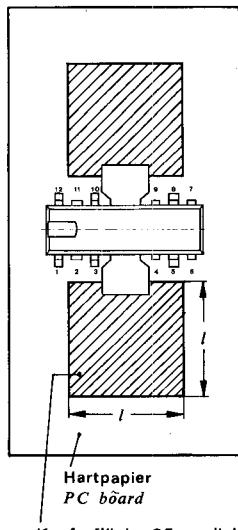
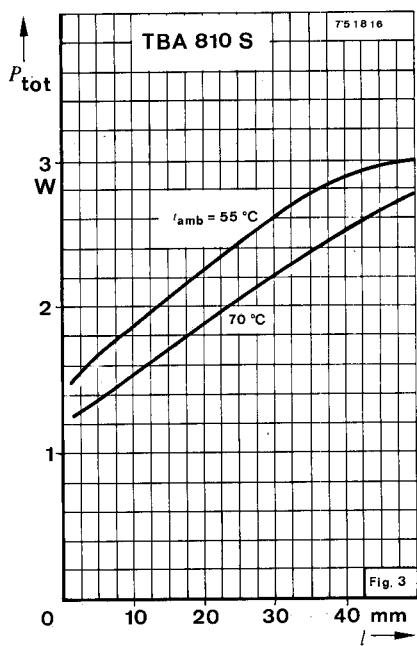
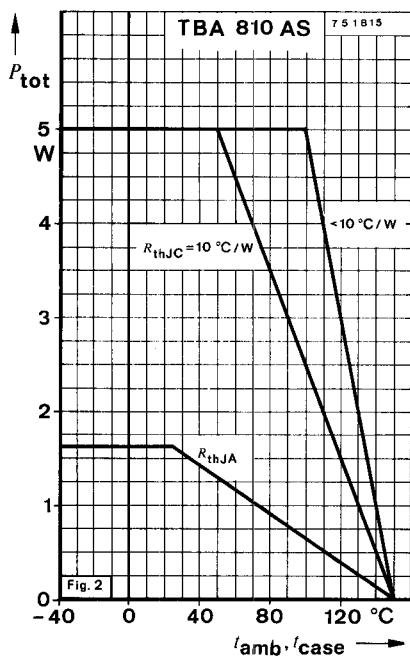


Fig. 4

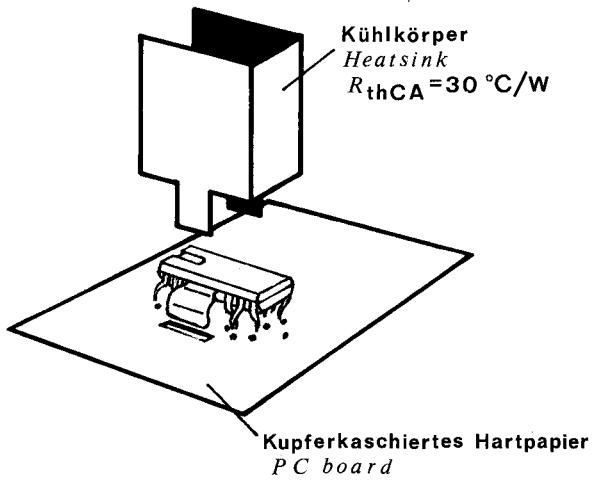


Fig. 5

# TBA 810 S · TBA 810 AS

## Wärmewiderstände

### Thermal resistances

	<b>TBA 810 S</b>	$R_{thJA}$	Min.	Typ.	Max.
Sperrsicht-Umgebung Junction ambient	<b>TBA 810 AS</b>	$R_{thJA}$	70	°C/W	
			80	°C/W	
Sperrsicht-Gehäuse Fig. 3, 4, 5 Junction case Fig. 2	<b>TBA 810 S</b>	$R_{thJC}^{(1)}$	12	°C/W	
	<b>TBA 810 AS</b>	$R_{thJC}^{(1)}$	10	°C/W	

## Elektrische Kenngrößen

### Electrical characteristics

$t_{amb} = 25^\circ\text{C}$ ,  $R_f = 56 \Omega$ , Bezugspunkt: Pin 9, Pin 10 falls nicht anders angegeben  
Reference point: unless otherwise specified

Versorgungsspannung Supply voltage	Pin 1	$U_S$	4	20	V		
Mittenspannung Quiescent output voltage	Fig. 13	Pin 12	$U_{QB}$	6,4	7,2	8	V
Ruhestrom der Gesamtschaltung Quiescent drain current	$U_S = 14,4 \text{ V}$	Fig. 12	Pin 1	$I_{SB}$	12	20	mA
Gesamtstromaufnahme Total supply current	$P_q = 6 \text{ W}$ , $U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$	Pin 1	$I_{S \text{ tot}}$	600			mA
Thermische Abschalttemperatur Thermal shut-down temperature	$P_{tot} = 2,8 \text{ W}$	Fig. 11		$t_{case}$	120		°C
Brummunterdrückung Supply voltage rejection ratio	$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$ , $f_{Br} = 100 \text{ Hz}$	Fig. 14, 15		$k_{SVR}$	48		dB
Eingangsstrom Input current	$U_S = 14,4 \text{ V}$	Pin 8	$I_{IB}$	0,4	4		μA
Ausgangsleistung Output power	Fig. 6, 8, 9, 10, 11						
	$R_L = 4 \Omega$ , $f = 1 \text{ kHz}$ , $k = 10\%$	$U_S = 16,0 \text{ V}$	$P_q$		7		W
		$U_S = 14,4 \text{ V}$	$P_q$	4,6	6		W
		$U_S = 9,0 \text{ V}$	$P_q$		2,5		W
		$U_S = 6,0 \text{ V}$	$P_q$		1		W
Eingangsspannung Input voltage	Pin 8	$U_i$			220		mV
Eingangsspannung Input voltage	Fig. 18	Pin 8					
	$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $P_q = 6 \text{ W}$ , $f = 1 \text{ kHz}$ , $R_L = 4 \Omega$ ,	$R_f = 56 \Omega$	$U_j$		80		mV
		$R_f = 22 \Omega$	$U_i$		35		mV

<sup>(1)</sup>) mit Kühlfläche  $R_{thCA} = 10^\circ\text{C/W}$   
with cooling plate

# TBA 810 S · TBA 810 AS

			Min.	Typ.	Max.	
Eingangswiderstand <i>Input resistance</i>	Pin 8	$R_i$	5		M $\Omega$	
Bandbreite (-3 dB) <i>Band width</i>	Fig. 16					
$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$ , $C_3 = 820 \text{ pF}$ $C_3 = 1500 \text{ pF}$	$B$		40 ... 20000		Hz	
Klirrfaktor <i>Distortion</i>	Fig. 6, 19, 20					
$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$ , $f = 1 \text{ kHz}$ , $P_q = 50 \text{ mW bis zu } 3 \text{ W}$	$k$		0,3		%	
Spannungsverstärkungen <i>Voltage amplifications</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$ , $f = 1 \text{ kHz}$						
Leerlauf <i>Open loop</i>		$A_{ug}$	80		dB	
mit Gegenkopplung <i>closed loop</i>	Fig. 17	$A_{uf}$	34	37	40	dB
Eingangsrauschspannung <i>Input noise voltage</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $B = 20 \dots 20000 \text{ Hz}$	Pin 8	$U_{ni}$	2		$\mu\text{V}$	
Eingangsrauschstrom <i>Input noise current</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$ , $B = 20 \dots 20000 \text{ Hz}$	Pin 8	$I_{ni}$	0,1		nA	
Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	Fig. 6, 9	$\eta$	70		%	
$P_q = 5 \text{ W}$ , $U_S = 14,4 \text{ V}$ , $R_L = 4 \Omega$ , $f = 1 \text{ kHz}$						

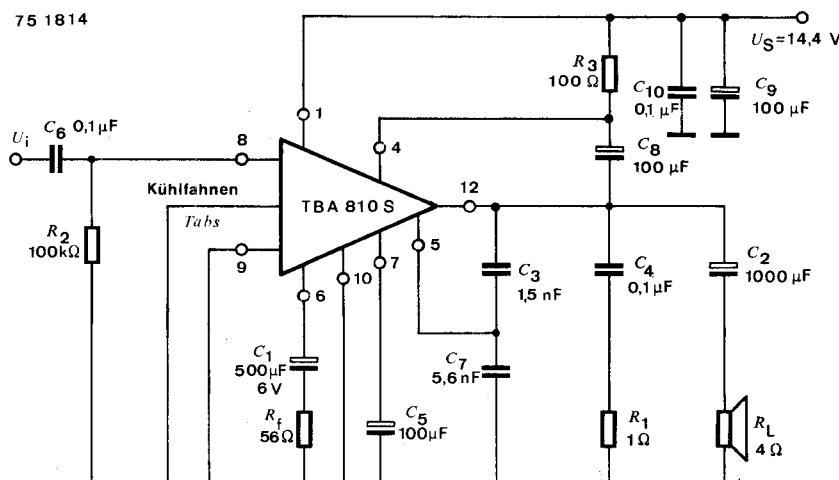
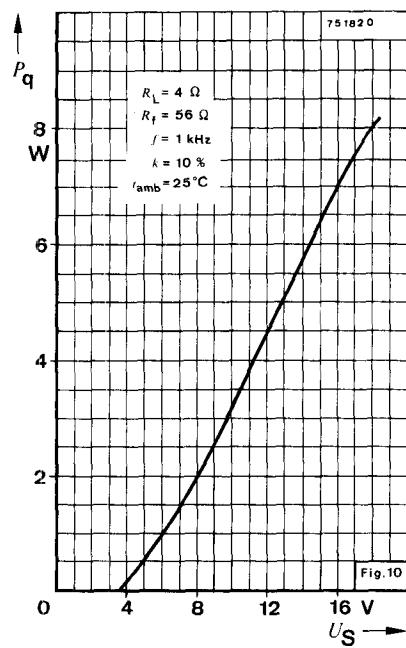
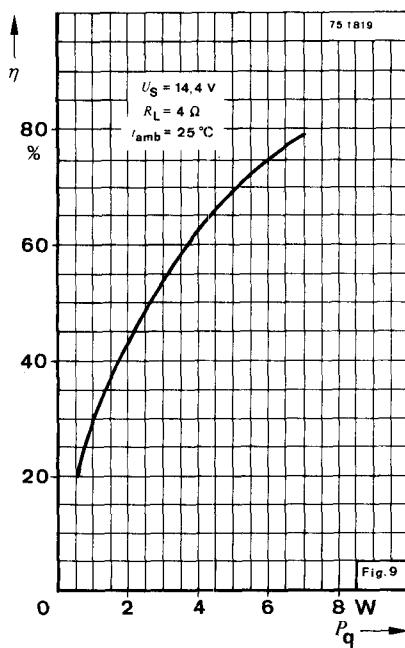
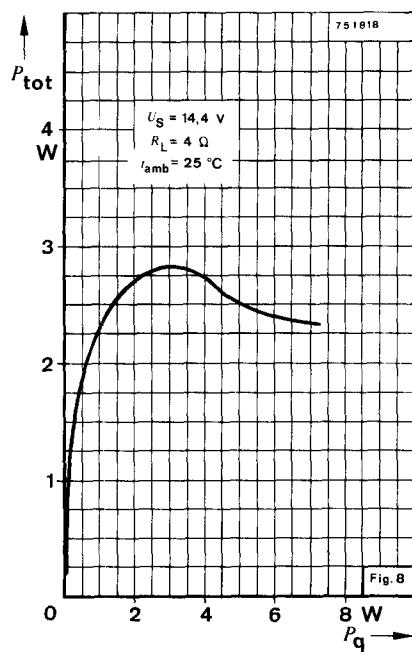
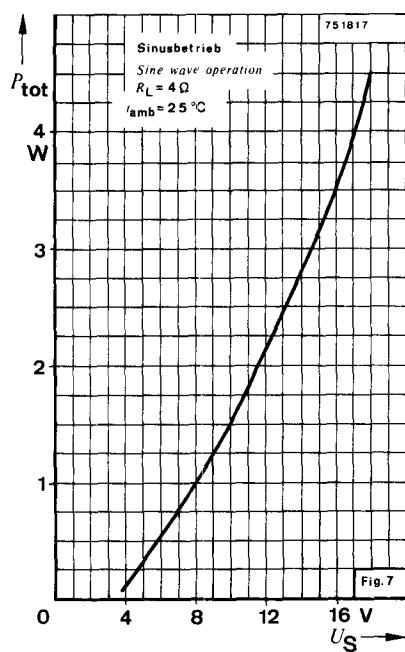
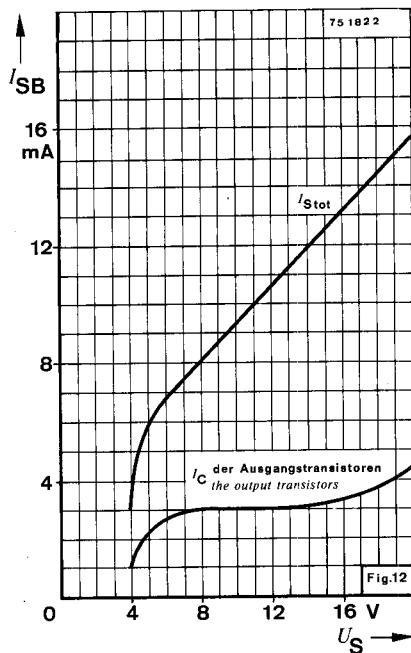
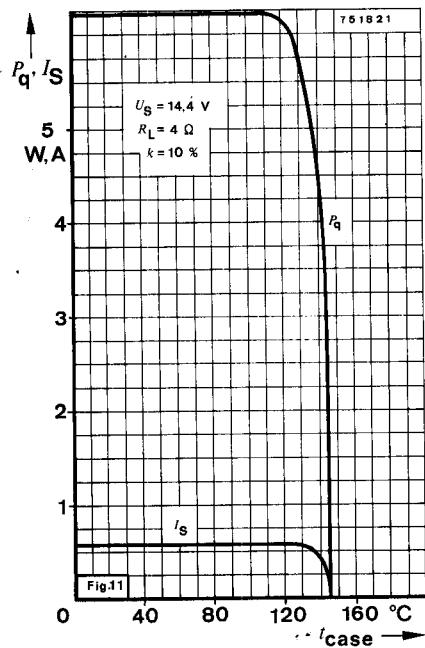


Fig. 6 Meßschaltung für:  $P_q$ ,  $P_{tot}$ ,  $k$ ,  $\eta$  und Anwendungsbeispiel  
Test circuit for:  
and application note

# TBA 810 S · TBA 810 AS

---





### Thermisches Abschalten:

Die eingebaute thermische Begrenzerschaltung ergibt folgende Vorteile:

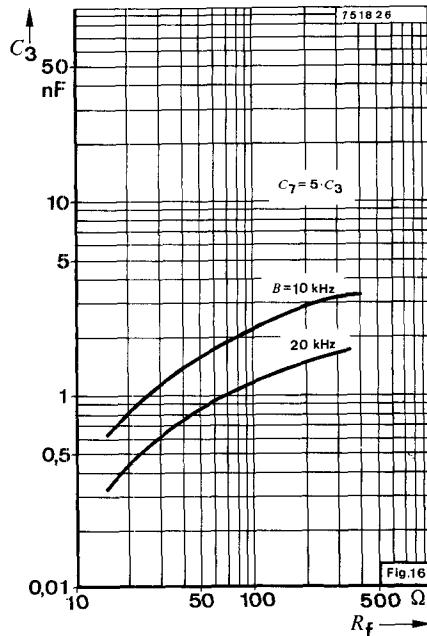
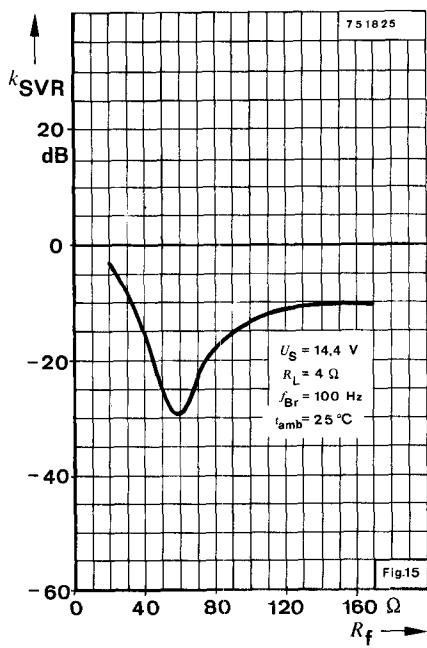
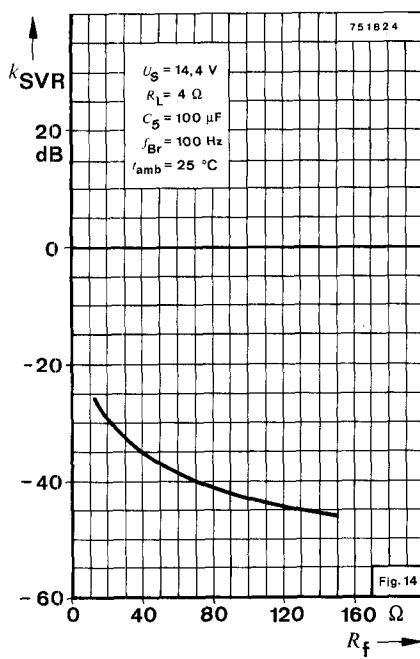
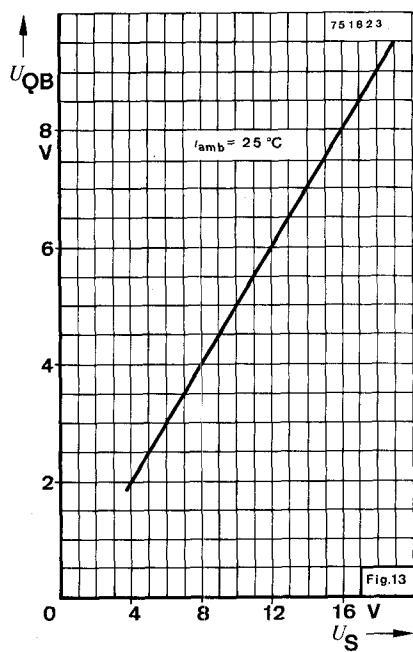
1. Eine dauernde Überlastung des Ausganges oder eine Erhöhung der zulässigen oberen Umgebungstemperatur kann einfach verhindert werden.
2. Die Kühlung kann gegenüber konventionellen Schaltungen mit einem kleineren Sicherheitsfaktor ausgelegt werden. Bei einer thermischen Überlastung wird der Schaltkreis nicht infolge einer zu hohen Sperrschichttemperatur zerstört, denn es wird ausschließlich  $P_Q$  (und somit  $P_{\text{tot}}$ ) und  $I_S$  reduziert (siehe Fig. 11).

### Thermal shut-down

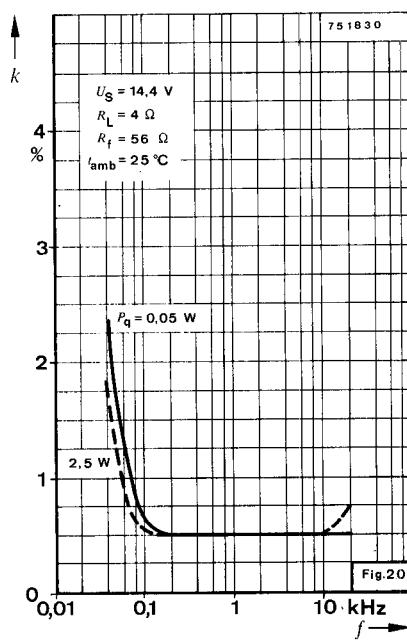
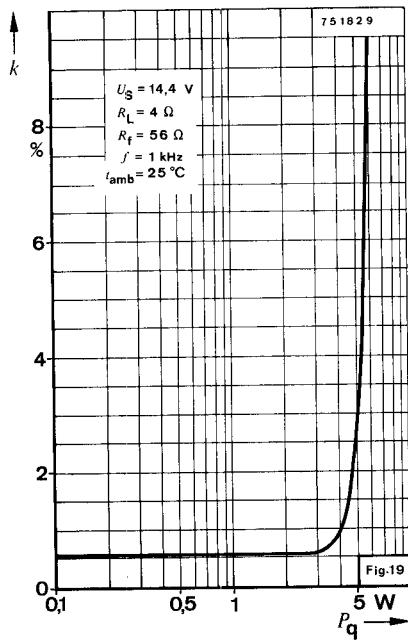
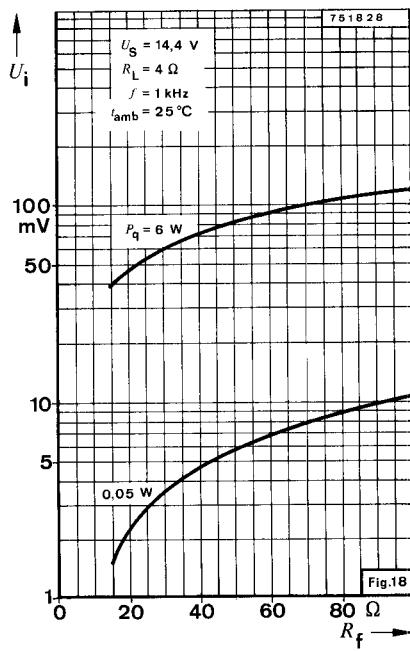
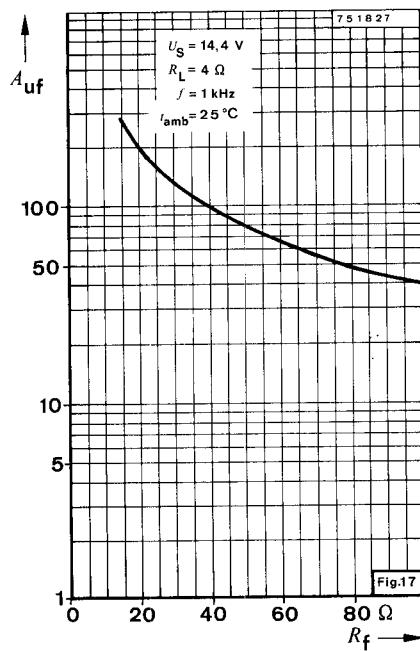
The presence of a thermal limiting circuit offers the following advantages:

1. An overload on the output (even if it is permanent), or an above-limit ambient temperature can be easily supported.
2. The heat sink can have a smaller factor of safety compared with that of a conventional circuit. There is no device damage in the case of too high a junction temperature; all that happens is that  $P_Q$  (and therefore  $P_{\text{tot}}$ ) and  $I_S$  are reduced (fig. 11).

# TBA 810 S · TBA 810 AS

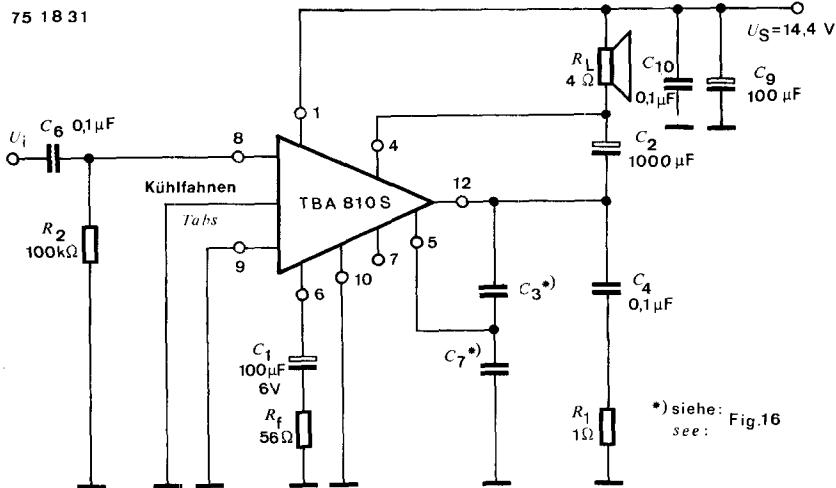


# TBA 810 S · TBA 810 AS



# TBA 810 S · TBA 810 AS

---



**Fig. 21** Schaltungsbeispiel mit hochliegendem  $R_L$   
*Circuit example with load connected to supply voltage*